

ESAB85M-009(5A)

富士小電力ダイオード

ショットキーバリアダイオード

SCHOTTKY BARRIER DIODE

■特長：Features

- 取り付け面が絶縁されたフルモールドタイプ
Insulated package by fully molding.
- 低 V_F
Low V_F
- スイッチングスピードが非常に速い
Super high speed switching.
- プレーナー技術による高信頼性
High reliability by planer design.

■用途：Applications

- 高速電力スイッチング
High speed power switching.

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Conditions	Ratings	Units
ピーク繰り返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}		90	V
ピーク非繰り返し逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	$t_w = 500\text{ns}, \text{duty} = \frac{1}{40}$	100	V
平均出力電流 Average Output Current	I_o	方形波, $\text{duty} = \frac{1}{2}, T_c = 95^\circ\text{C}$ Square wave	5.0*	A
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	正弦波 Sine Wave 10ms	60	A
接合温度 Operating Junction Temperature	T_j		-40 ~ +125	°C
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-40 ~ +125	°C

* センタータップ平均出力電流

* average forward current of centertap full wave connection

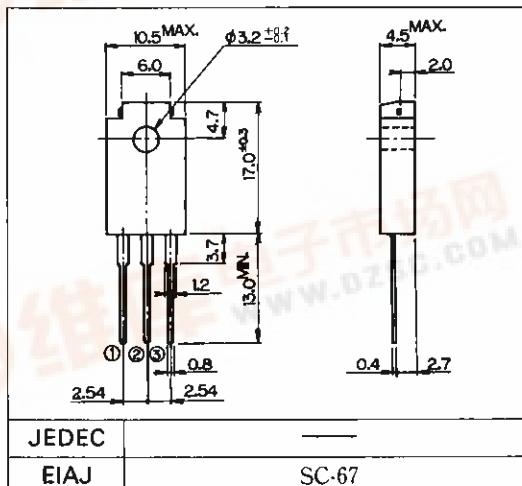
●電気的特性(特に指定がない限り周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$ とする)

Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified)

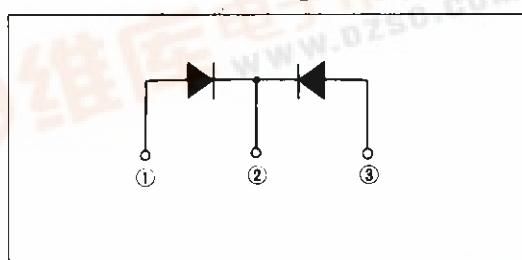
Items	Symbols	Conditions	Max.	Units
順電圧 Forward Voltage Drop	V_{FM}	$I_{FM} = 2.0\text{A}$	0.9	V
逆電流 Reverse Current	I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	2.0	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合・ケース間 Junction to case	5.0	°C/W

A

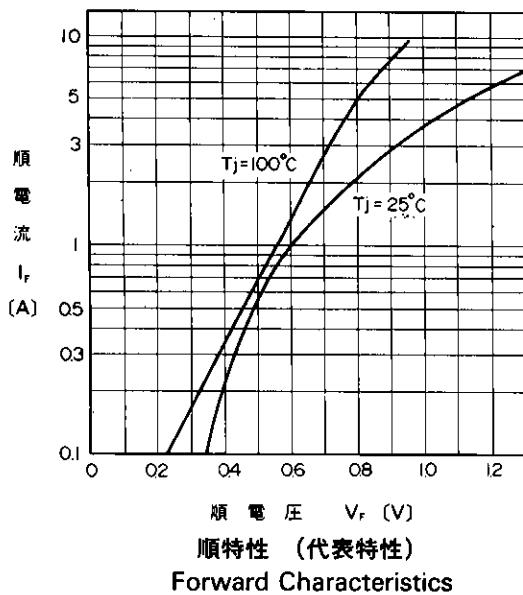
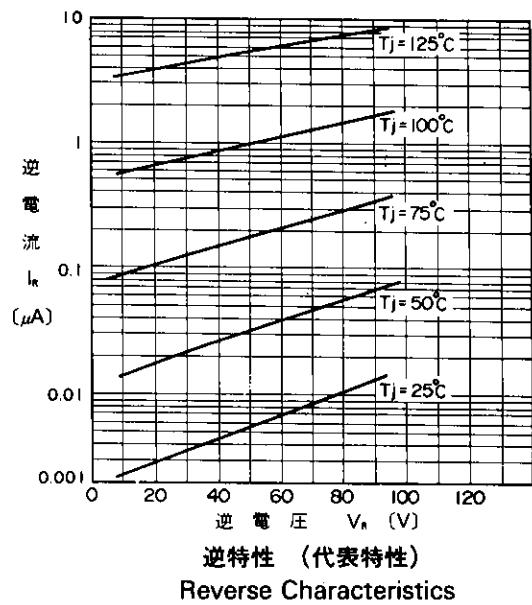
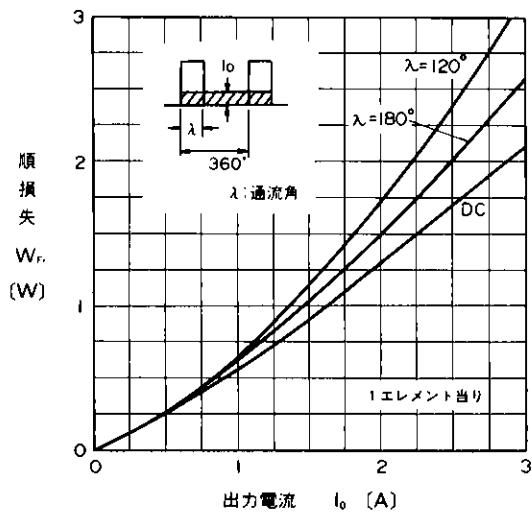
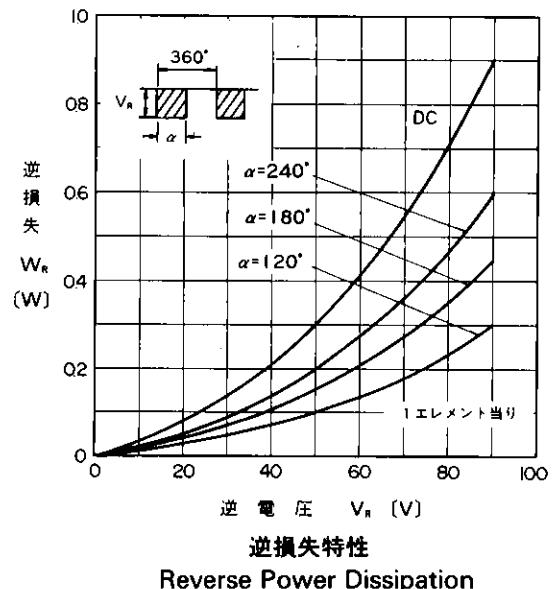
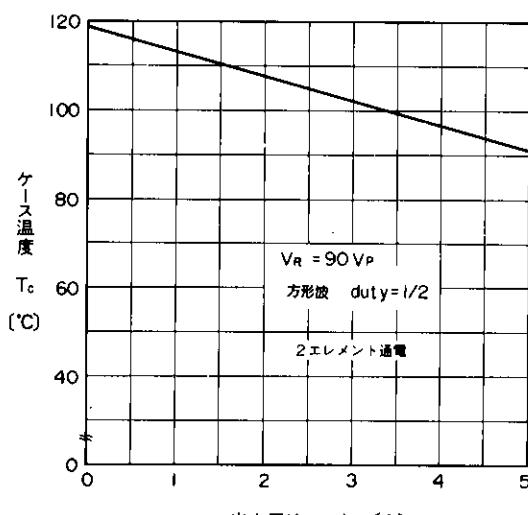
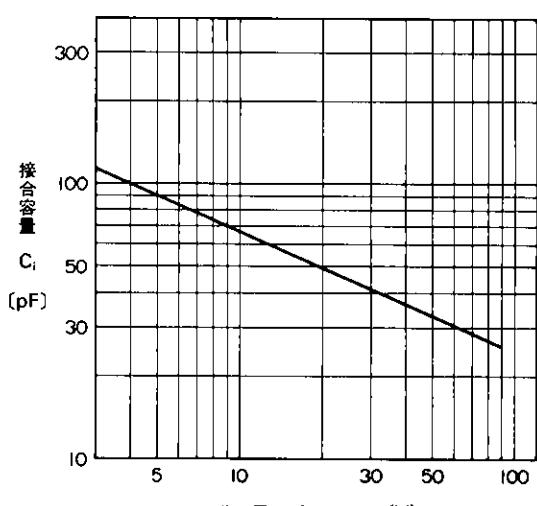
■外形寸法：Outline Drawings



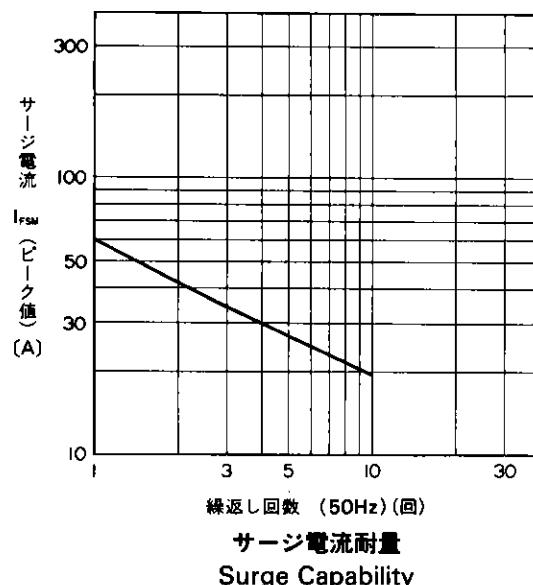
■電極接続 Connection Diagram



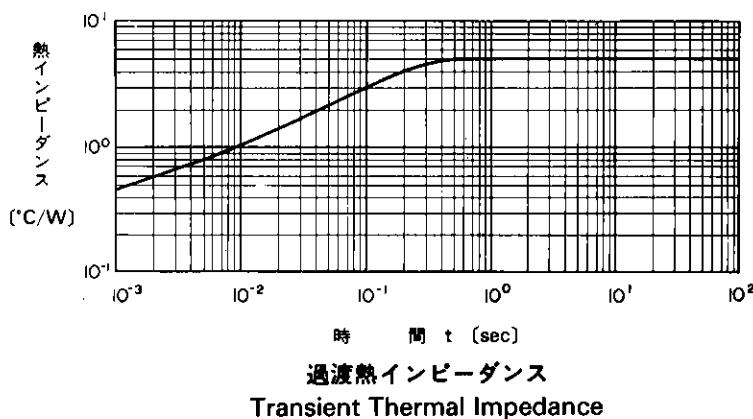
■特性曲線：Characteristics

順特性（代表特性）
Forward Characteristics逆特性（代表特性）
Reverse Characteristics順損失特性
Forward Power Dissipation逆損失特性
Reverse Power Dissipation出力電流—ケース温度特性
Output Current-Case Temperature接合容量特性（代表特性）
Junction Capacitance Characteristics

A



サージ電流耐量
Surge Capability



過渡熱インピーダンス
Transient Thermal Impedance

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>